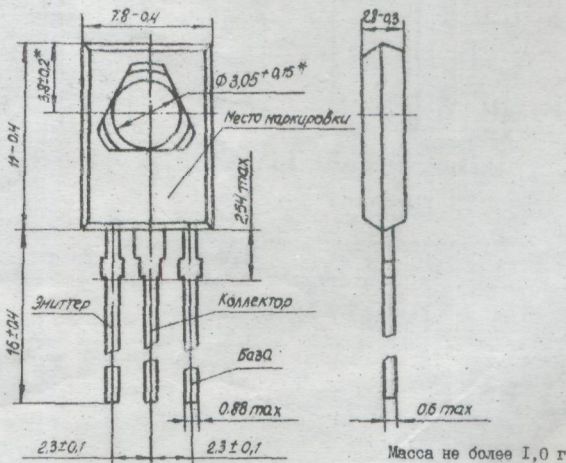




Транзисторы типов КТБ16А, КТБ16Б,  
КТБ16В, КТБ16Г

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы типов КТБ16А, КТБ16Б, КТБ16В, КТБ16Г в пластмассовом корпусе, предназначенные для применения в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения, изготавливаемые для народного хозяйства.



Основные электрические параметры при  $T_{cp} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обоз- начение	Н о р м а							
		КТБ16А		КТБ16Б		КТБ16В		КТБ16Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент переда- чи тока ( $I_3 = I_A$ , $U_{КБ} = 2 В$ )	$h_{213}$	25	275	25	275	25	275	25	275
Граничное напряжение ( $I_3 = 0,1 А$ , $t_u = 0,3-1 мс$ ), В	$U_{К3020}$	25		45		60		80	
Обратный ток коллектора ( $U_{КБ} = 40 В$ )	$I_{К30}$		100		100		100		100
( $U_{КБ} = 45 В$ )					100				
( $U_{КБ} = 60 В$ )						100			
( $U_{КБ} = 100 В$ ), мкА									100
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $I_K = I_A$ , $I_3 = 0,1 А$ ), В	$U_{КЭнас}$		0,6		0,6		0,6		0,6

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	Н о р м а								
		КТ816А		КТ816Б		КТ816В		КТ816Г		
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	
Обратный ток коллектор- эмиттер ( $R_{бэ} \leq 1 \text{ кОм}$ ) ( $U_{кэ} = 40 \text{ В}$ ) ( $U_{кэ} = 45 \text{ В}$ ) ( $U_{кэ} = 60 \text{ В}$ ) ( $U_{кэ} = 100 \text{ В}$ ), мкА	$I_{кэ}$		200		200			200		200

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ:

Золото - г

ДРАГМЕТАЛЛЫ НА ВЫВОДАХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ816А, КТ816Б, КТ816В, КТ816Г соответствуют техническим условиям  
АА0.336.186 ТУ/02.

Место для  
штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена"

Место для  
штампа ОТК